

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ (π -MOS)

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

2SK385

- 高速高電圧スイッチング用
- スwitchングレギュレータ, DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用

通信工業用

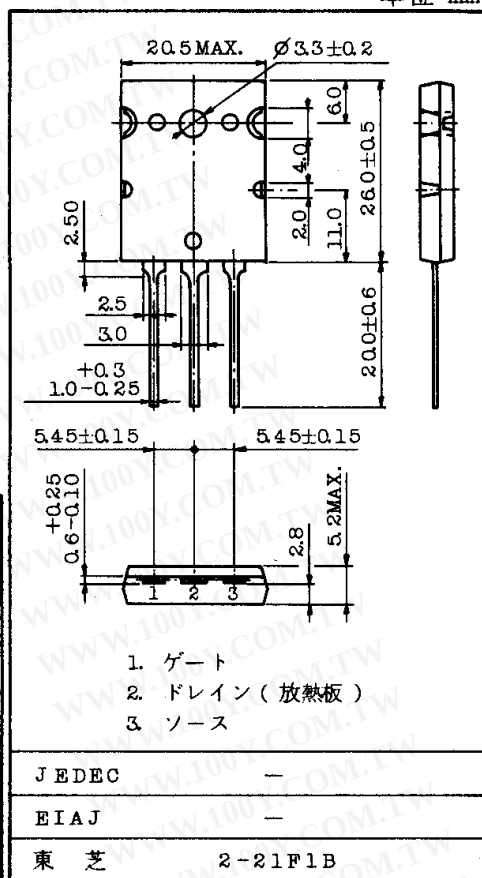
単位 mm

特 長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{(BR)DSS}=400V$
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。 : $|Y_{fs}|=5S$ (標準) ($I_D=5A$)
- ・ 漏れ電流が低い。 : $I_{GSS}=\pm 100nA$ (最大) ($V_{GS}=\pm 20V$)
 $I_{DSS}=1mA$ (最大) ($V_{DS}=400V$)
- ・ 取扱いが簡単な, エンハンスメントタイプです。

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSX}	400	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	DC	I_D	A
	パルス	I_{DP}	A
許容損失 ($T_c=25^\circ C$)	P_D	120	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0$	—	—	± 100	nA
ドレインシャ断電流	I_{DSS}	$V_{DS}=400V, V_{GS}=0$	—	—	1.0	mA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=10mA, V_{GS}=0$	400	—	—	V
ゲートしきい値電圧	V_{th}	$V_{DS}=10V, I_D=1mA$	1.5	—	3.5	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=5A$	3.0	5.0	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D=5A, V_{GS}=10V$	—	0.45	0.6	Ω
ドレイン・ソース間オン電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D=10A, V_{GS}=10V$	—	5	7	V
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	1500	2000	pF
帰 還 容 量	C_{rss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	140	300	pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	400	600	pF
スイッチング 時 間	上 昇 時 間	t_r	—	50	100	ns
	ターンオン時間	t_{on}	—	80	150	ns
	下 降 時 間	t_f	—	80	150	ns
	ターンオフ時間	t_{off}	—	350	700	ns

